

Физика и техника полупроводников, 2021, том 55, выпуск 4

Электронные свойства полупроводников

Рагимов С.С., Багиев В.Э., Алиева А.И., Саддинова А.А.

О ширине запрещенной зоны AgSbSe_2

291

Астров Ю.А., Порцель Л.М., Шуман В.Б., Лодыгин А.Н., Абросимов Н.В., Павлов С.Г., Hubers H.-W.

Оптические сечения поглощения и силы осцилляторов двойного донора магния в кремнии

299

Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Ушаков В.В., Аминев Д.Ф., Кривобок В.С.

Внутрицентровые излучательные переходы на примесных центрах железа в селениде цинка

304

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Поддубный А.Н.

Направленные поверхностные акустические волны в нецентросимметричных решетках

308

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Кочман И.В., Михайлова М.П., Вейнгер А.И., Парфеньев Р.В.

Магнитофононные осцилляции магнитосопротивления в квантовой яме InAs/GaSb с инвертированным зонным спектром

313

Жуков Н.Д., Гавриков М.В., Кабанов В.Ф., Ягудин И.Т.

Одноэлектронный эмиссионно-инжекционный транспорт в микроструктуре с коллоидными квантовыми точками узкозонных полупроводников

319

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Давыдов С.Ю., Посредник О.В.

Адсорбция атомов II и VI групп на политипах карбида кремния

326

Сидоров Г.Ю., Сидоров Ю.Г., Швец В.А., Варавин В.С.

Образование акцепторных центров в CdHgTe под воздействием воды и термообработок

331

Физика полупроводниковых приборов

Кузаян А.А.

Полупроводниковый сенсор термоэлектрического однофотонного детектора для регистрации излучения ближнего ИК диапазона

336

Шашкин И.С., Лешко А.Ю., Шамахов В.В., Воронкова Н.В., Капитонов В.А., Бахвалов К.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Копьев П.С.

Мощные непрерывные лазеры InGaAs/AlGaAs (1070 нм) с расширенным латеральным волноводом мезаполосковой конструкции

344

Иванов П.А., Лебедева Н.М., Ильинская Н.Д., Самсонова Т.П., Коньков О.И.

Высоковольтные лавинные 4H-SiC диоды с прямой фаской

349

Obi U.C., Sanni D.M., Bello A.

Effect of Absorber Layer Thickness on the Performance of Bismuth-Based Perovskite Solar Cells

354

Sanjay , Prasad B., Vohra A.

Performance Evaluation of Inversion Mode and Junctionless Dual-Material Double-Surrounding Gate Si Nanotube MOSFET for 5-nm Gate Length

355

Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Родин С.Н., Кибалов Д.С., Смирнов В.К.

Образование полуполярных III-нитридных слоев на поверхности $\text{Si}(100)$, структурированной с помощью самоформирующейся наномаски

356

- Кудряшов Д.А., Максимова А.А., Вячеславова Е.А., Уваров А.В., Морозов И.А., Баранов А.И.,
Монастыренко А.О., Гудовских А.С.
**Исследование влияния особенностей конструкции установки магнетронного распыления на
электрические и оптические свойства пленок оксида индия-олова** 360
- Марков Л.К., Павлюченко А.С., Смирнова И.П., Меш М.В., Колоколов Д.С.
**Применение метода атомно-слоевого осаждения для получения наноструктурированных
покрытий ITO/Al₂O₃** 365
- Ложкина Д.А., Астрова Е.В., Соколов Р.В., Кириленко Д.А., Левин А.А., Парфеньева А.В., Улин В.П.
**Формирование кремниевых нанокластеров при диспропорционировании монооксида
кремния** 373
- Rabehi A., Akkal B., Amrani M., Tizi S., Benamara Z., Helal H., Douara A., Nail B., Ziane A.
**Current--Voltage, Capacitance--Voltage--Temperature, and DLTS Studies of Ni|6H-SiC Schottky
Diode** 388